येष येष येष विष



103-205-8000

中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件,係本局存檔中原申請案的副本,正確無記, 其申請資料如下

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this office of the application as originally filed which is identified hereunder:

日 : 西元 2003 年 Application Date

申 $\stackrel{.}{\sim}$ 0921-05266 Application No.

財團法人工業技術研究院 Applicant(s)

Director General



西元 2003 年 6 發文日期:

Issue Date

09220561930 發文字號:

Serial No.

SP යට වර වල වල වල වල වල වල වල වල වල වල

申請日期:	IPC分類	1
申請案號:		
		J

/ .		
(以上各欄 日	日本局填記	發明專利說明書
-	中文	固態電解電容器以及其製造方法
發明名稱	英文	
	姓 名 (中文)	1. 蔡麗端 2. 杜佾璋
=		1.Li-Duan TSAI 2.Yi-Chang DU
發明人 (共2人)	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW 2. 中華民國 TW
	住居所 (中 文)	1. 新竹縣竹東鎮中興路四段195號 2. 新竹縣竹東鎮中興路四段195號
	住居所 (英 文)	1. Bldg. 77, 195-5 Sec. 4, Chung Hsing Rd. Chutung, Hsinchu, Taiwan 31015, R.O.C 2. Bldg. 77, 195-5 Sec. 4, Chung Hsing Rd. Chutung, Hsinchu, Taiwan
	名稱或 姓 名 (中文)	1. 財團法人工業技術研究院
	名稱或 姓 名 (英文)	1. INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE
=	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
申請人(共1人)	住居所 (營業所) (中 文)	
	住居所 (營業所) (英 文)	1.
	代表人(中文)	1. 翁政義
	代表人(英文)	1. Cheng-I WENG
	11.1	SP.RUMINOSCOLERALIZAÇÃO PROMINI DE CERMINI



四、中文發明摘要 (發明名稱:固態電解電容器以及其製造方法)

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明:

六、英文發明摘要 (發明名稱:)





四、中文發明摘要 (發明名稱:固態電解電容器以及其製造方法)

- 1 正極鋁
- 2 氧化鋁介電層
- 3 電解質
 - 3-1 導電性高分子
 - 3-2 非共軛高分子
- 4 隔離紙
- 5 負極鋁

六、英文發明摘要 (發明名稱:)



一、本案已向			
國家(地區)申請專利	申請日期	案號	主張專利法第二十四條第一項優先機
	•		
		無	
		 .	
	•		
二、□主張專利法第二十	- 五條之一第一項	原生链 。	
	五條之 第一項	度 几 作 .	
申請案號:		無	
日期:			
三、主張本案係符合專系	法第二十條第一	項□第一款但書	或□第二款但書規定之期間
日期:	٠		
四、□有關微生物已寄存	字於國外:		
寄存國家: 寄存機構:		無	
寄存日期:		,	
寄存號碼:	- u m - / 1 m - / 1	المعدد عادد علم وطعر المحدد عا	
□有關微生物已寄存 寄存機構:	子於國內(本局所書	盲定之奇仔機構)	:
寄存日期:		無	
寄存號碼: □熟習該項技術者》	且	- .	
	70.70000000000000000000000000000000000	+ •	
一般这些铁铁铁铁			

五、發明說明(1)

【發明所屬之技術領域】

本發明係為一種電容器之製造方法,特別是一種將固態電解電容器之電解質部分,透過其導電性高分子與非共軛高分子作用產生具有較佳的製程良率、熱穩定性與可靠度之固態電解電容器以及其製造方法。

【先前技術】

由於導電性高分子較傳統電解電容器所用的液態電解液或是固態有機半導體錯鹽,如TCNQ複合鹽,有更高的導電度,且具有適度的高溫絕緣化特性,因此導電性高分子成為現今電解電容器所使用之固態電解質的開發潮流。

最早將導電性高分子應用於電解電容器之電解質之文獻,可見諸於Jesse S. Shaffer等人於1983年所申請之美國專利4609971。其方法是將可溶性的polyaniline粉末及摻離劑LiC104溶於含水之butyrolactone中,再將電容器之陽極鋁箔含浸此混合溶液,隨後並將鋁箔上的溶劑驅除,完成電解質的含浸工作。由於polyaniline等導電性高分子不易滲入陽極箔等閱金屬之微孔中,因此此法所得之電容器之含浸率差、阻抗高。因此在隨後的研究中Tsuchiya等人先在電容器之介電層表面以高溫裂解法形成二氧化錳,再以電化學法形成高導電度的導電性高分子層。

此外,Gerhard Hellwig, Stegen等人首先於美國專利4803596號揭露以化學氧化聚合法將導電性高分子作為電容器之電解質。其方法是將電容器正箔分別含浸導電性





五、發明說明 (2)

高分子單體及氧化劑溶液後,於適當條件下使導電性高分子單體聚合,如此反覆多次以累積足夠的導電性高分子電解質之厚度。

因此,如何提高高分子電解質之機械強度與物理結構之熱穩定性,為開發固態電解電容器所必需面對之重要課題。





五、發明說明(3)

絕緣化,使電容器漏電流極高甚至發生短路的現象。若使用絕緣性的材質如玻璃纖維,將會使電解質的整體導電度下降。且於電解質中添加纖維的做法無法解決導電性高分子本身與電極表面接著性不佳的問題,在長時間的使用環境中,導電性高分子最終仍有可能從電極表面剝離。

歐洲專利0617442揭露在含有導電性高分子單體、電 解質溶劑所組成的電化學聚合反應的溶液中添加具有 carboxylic acid 或hydroxyl 官能基的高分子。以此電化 學聚合溶液所聚合形成的導電性高分子電解質與電容器素 子之陽極表面具有良好的接著特性且電容器在高溫高濕的 環境中仍可保持良好的特性與可靠度。然而此法只能使用 可溶解性的線性高分子(linear polymer),故此種導電性 共 軛 高 分 子 與 線 性 高 分 子 所 組 成 的 聚 掺 合 物 (polymer blend) 不如交聯結構高分子,且必須考量不同高分子間的 相容性問題,以避免高溫發生相分離,因此在高分子的選 擇上有許多的限制。再者,許多機械性質與熱性質良好的 高分子,僅能溶於非醇系的有機溶液中,故此法僅適於聚 合溶液為非醇系有機溶劑系統之電化學聚合法,對於以水 相聚合的導電性高分子如polyaniline,或是基於含浸液 穩定性等因素的考量,而使用醇類溶劑的化學氧化聚合 法,上述的方法並不適用

【發明內容】

有鑑於此,本發明係提供一種具有高機械強度、熱穩定性物理結構、較佳的製程良率、以及可靠度之固態電解





五、發明說明(4)

電容器以及其製造方法,本發明所揭露之步驟流程包含首先在電容器素子之正負極間形成導電性高分子層,接著將電容器素子含浸於非共軛高分子溶液中,然後在適當條件下引發交聯和聚合反應的發生,藉以於電容器素子之正負櫃形成互穿網或半互穿網狀結構(intrepenetration or semi-interpenetration network)之導電性複合物質,最後封裝電容器素子並且進行充電老化修補電容器素子之漏電,藉以完成該電解電容器之製造過程。

透過本發明所揭露的方法流程,可以改善固態電解電容器之固態電解質之機械強度、物理結構之熱穩定性以及電解質與電容器正負極間的界面接著特性以提高電容器之製程良率及使用可靠度。

【實施方式】

本發明所揭露之固態電解電容器係包含填充於電容器素子正負極間之電解質,如「第1圖」揭露本發明之電容器結構示意圖,圖中顯示正極鋁1、氧化鋁介電層2、電解質3、隔離紙4、負極鋁5之結構相對配置關係,其中電解質係由導電性高分子3-1與非共軛高分子3-2之分子鏈拔充之複合物質。此一複合電解質與經穿插或交聯所構成之複合物質。此一複合電解質科於隔離紙之纖維空隙與正負極之空間並滲入正負極微光中產生作用所形成之導電性複合物質所構成,此電解質之能構係為互穿網結構或者是半互穿網結構,介於固態電性





五、發明說明 (5)

高分子,可為(口塞)吩化合物(thiophene)、(口比)咯pyrrole、苯胺(aniline)以及此三種單體之相關衍生物之導電性高分子化合物;而非共軛高分子係可為含有環氧基(epoxy)、含有氫氧基(hydroxyl)以及含有羧基

(carboxy1)之高分子化合物、前驅化合物或前驅物之交聯化合物;此一固態電解電容器同時具有界面粘著性、機械性質與物理結構熱穩定性的互穿網或半互穿網結構的固態電解電容器之高分子電解質;在製程中非共軛高分子層亦可同時包覆於固態電解電容器素子外圍,用以提昇該固態電解電容器素子之機械性質。

本發明所揭露固態電解電容器之製造方法係為首先在電客器素子之近負極間形成導電性高分子之後,利用浸於生高分子結構呈疏鬆多孔狀態的特性,將此素子含點物(precursor)溶液中,使此非共軛高分子液體能夠充子酸體的非共軛高分子之微型,並於隨後再將此高分子之微型,並於隨後再將此高分子之微型,並於隨後再將此高分子之微型,於大樓上面,以形成五字網狀或半五字網狀(intrepenetration or semi-interpenetration network)結構的複合物質同時具有導電性高分子網狀以橡膠蓋對口,再進行充電老化修補電容器之漏。於電器製作。此複合物質同時具有導電性高分子所具有的物理結構熱穩定性、機性質及與電容器正負極間的界面接著性。





五、發明說明 (6)

【實施例】

以電化學電解反應所形成之氧化鋁介電層之正極鋁箔與電化學腐蝕之高表面積負極鋁箔彼此以馬尼拉紙(Manila paper)作為隔離紙捲繞成電容器素子。取 Fe(III) tosylate與溶劑溶解後,再與EDT單體混合,並以上述之電容器素子含浸此一混合溶液。此一含浸混合溶液之電容器素子於高溫環境充分反應並累積達一定的電解質厚度後,以溶劑清洗並驅除素子中多餘的溶劑,之後將將上之環範對的有機溶液中;此外,為了使非共軛高分子之單體或前驅物可以充分滲電性高分子之孔隙,因此必須控制非共軛高分子之單體或前驅物之點度。本實施例藉由添加有機溶劑於環範點的之點度,並且將環範斷點度控制於200cps/25℃左右。

此一含浸有環氧樹脂之電容素子隨後於高溫環境中驅除溶劑並使環氧樹脂充分進行交聯反應後套入鋁殼,以橡膠蓋封口,進行充電老化修補電容器之漏電,完成此一電容器製作。此一電容器隨後置於105℃之環境中進行可靠度加速測試。本實施例共製作五顆電容器,其電容器特性、製程良率與可靠度加速試驗之良率結果如附件1所示。

【比較例】

如同實施例取 Fe(III) tosylate以有機溶劑溶解後,再與EDT單體混合,並以實施例所述之電容器素子含





五、發明說明 (7)

浸此一混合溶液。此一含浸混合溶液之電容器素子於高溫環境充分反應後並累積達一定的電解質厚度之後,溶劑清洗並驅除素子中的溶劑後,套入鋁殼中並以橡膠蓋對口,進行充電老化修補電容器之漏電,完成此一電容器製作。此一電容器隨後置於105℃之環境中進行可靠度加速測。本比較例共製作五顆電容器,其電容器特性、製程良率與可靠度加速試驗之良率結果如附件1所示。

本發明所採行之電容器製程良率測定以電容器通電一分鐘後漏電流小於250mA,120Hz靜電容量大於330mF,120Hz等效串聯電阻小於150mW為良品判定標準。可靠度測試是在105℃,16V直流電壓下以1000小時之靜電容量變化小於10%,一分鐘漏電流小於250mA,120Hz等效串聯電阻小於150mW為判定標準。電容器經過充電老化後之製程良品為可靠度測試之良率計算基準。

從附件1的結果可發現,雖然以比較例步驟所製作之電容器的120Hz等效串聯電阻與實施例相近,但是從電容器開始含浸電解質經過清洗、乾燥、封裝及充電老化等製程步驟之後的製程良率卻優於比較例,而且經過可靠度測試之後,仍可保持優良的特性;反之,以比較例之製程步驟所製作之電容器製程良率不如實施例,且經過1000小時的可靠度測試之後,一半的電容器的一分鐘漏電流紛紛大幅爬升,良率僅及50%。

以上所述者,僅為本創作其中的較佳實施例而已,並非用來限定本創作的實施範圍;即凡依本創作申請專利範





Ŧ	,	孫昭	說明	(8)
ᅭ	•	% 4万	57L 173	เดา

圍所作的均等變化與修飾,皆為本創作專利範圍所涵蓋。



圖式簡單說明

第1圖係為本發明之電容器結構示意圖;

附件1係說明本發明所揭露之電容器特性、製程良率與可靠度加速試驗之良率結果比較表。

【圖式符號說明】

- 1 正極鋁
- 2 氧化鋁介電層
- 3 電解質
- 3-1 導電性高分子
- 3-2 非共軛高分子
- 4 隔離紙
- 5 負極鋁



六、申請專利範圍

- 一種固態電解電容器,係包含填充於一電容器素子正負極間之一電解質,其特徵在於該電解質係由一導電性高分子以及一非共軛高分子產生作用所形成之一導電性複合物質所構成,其中該電解質介於該固態電解電容器之正負極之間。
- 2. 如申請專利範圍第1項所述之固態電解電容器,其中該 導電性複合物質係包含一互穿網狀結構 (intrepenetration network) 導電性複合物質。
- 3. 如申請專利範圍第1項所述之固態電解電容器,其中該 導電性複合物質係包含一半互穿網狀結構(semi-

interpenetration network) 導電性複合物質。

- 4. 如申請專利範圍第1項所述之固態電解電容器,其中該 導電性高分子係為一共軛導電性高分子,係選自一 (口塞)吩化合物(thiophene)、一(口比)咯 (pyrrole)、一苯胺(aniline)以及此三種單體之相關 衍生物之導電性高分子化合物所組成群組中之一個。
- 5. 如申請專利範圍第1項所述之固態電解電容器,其中該 導電性高分子係為一聚3,4乙烯二氧(口塞)吩(poly (3,4-ethylenedioxythiophene))。
- 6. 如申請專利範圍第1項所述之固態電解電容器,其中該非共軛高分子係選自一含有環氧基(epoxy)、一含有氫氧基(hydroxyl)以及含有羧基(carboxyl)之高分子化合物所組成之群組中之一個。
- 7. 如申請專利範圍第1項所述之固態電解電容器,其中該





六、申請專利範圍

非共軛高分子係選自一含有環氧基(epoxy)、一含有氫氧基(hydroxyl)或含有羧基(carboxyl)之前驅化合物所組成之群組中之一個。

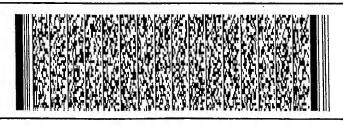
- 8. 如申請專利範圍第1項所述之固態電解電容器,其中該非共軛高分子係選自一含有環氧基(epoxy)、一含有氫氧基(hydroxyl)或含有羧基(carboxyl)之前驅物所構成交聯化合物所組成之群組中之一個。
- 9. 如申請專利範圍第1項所述之固態電解電容器,其中該電容器素子之外圍係包覆一層非共軛高分子層。
- 10. 一種固態電解電容器之製造方法,該方法步驟包含有:

於一電容器素子之正負極間填入一導電性高分子;

將該電容器素子含浸於一非共軛高分子溶液中, 並在一適度條件下引發聚合與交聯反應,藉以於該電容器素子之正負極間形成一導電性複合物質;及

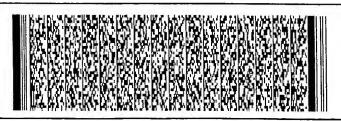
封裝該電容器素子並且進行充電老化以修補該電容器素子之漏電。

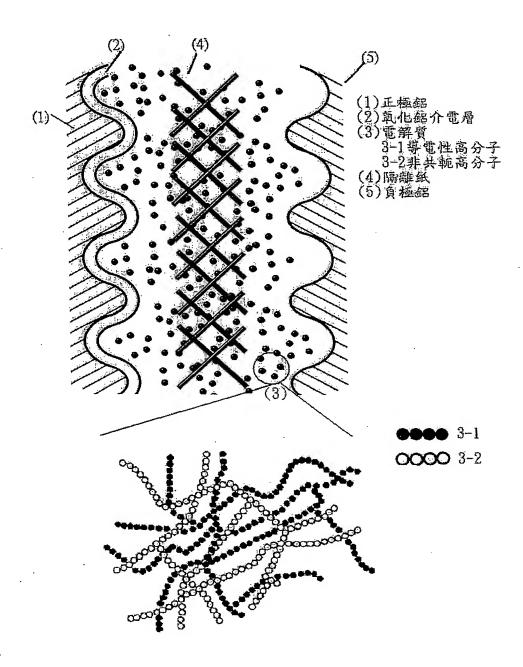
- 11. 如申請專利範圍第10項所述之固態電解電容器之製造方法,其中該非共軛高分子溶液係包含一非共軛高分子單體。
- 12. 如申請專利範圍第10項所述之固態電解電容器之製造方法,其中該非共軛高分子溶液係包含一非共軛高分子前驅物。



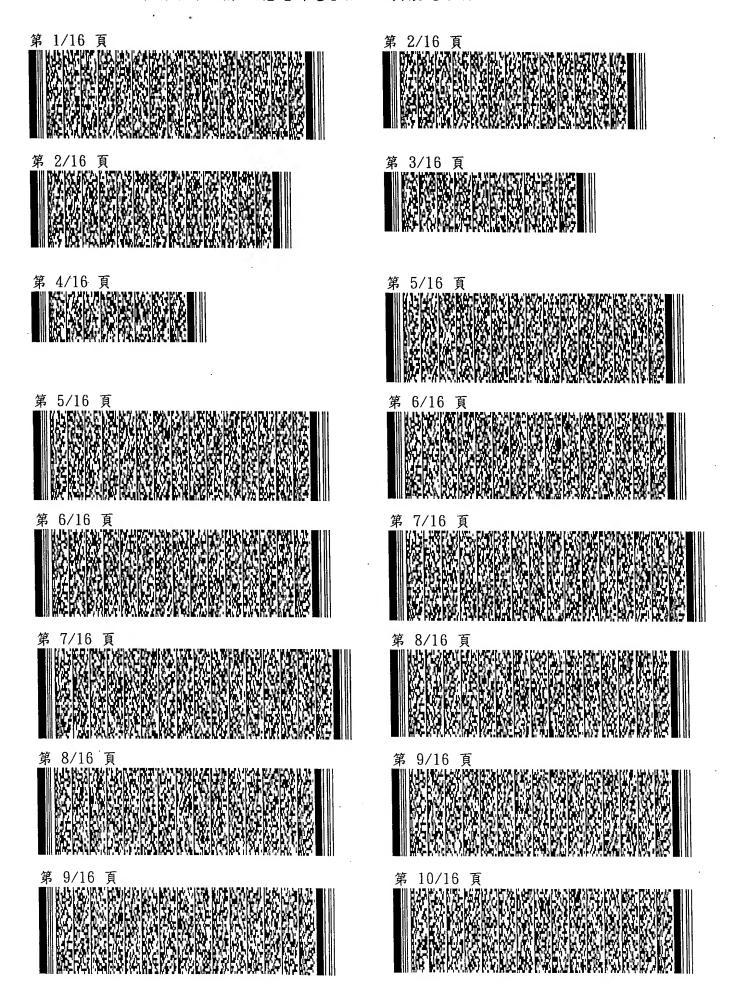
六、申請專利範圍

- 13. 如申請專利範圍第10項所述之固態電解電容器之製造方法,其中該導電性高分子係為一共軛導電性高分子,係選自一(口塞)吩化合物(thiophene)、一(口比)咯(pyrrole)、一苯胺(aniline)以及此三種單體之相關衍生物之聚合高分子組成群組中之一個。
- 14. 如申請專利範圍第10項所述之固態電解電容器之製造方法,其中該導電性高分子係為一聚3,4乙烯二氧(口塞)吩(poly(3,4-ethylenedioxythiophene))。
- 15. 如申請專利範圍第10項所述之固態電解電容器之製造方法,其中該非共軛高分子係選自一含有環氧基(epoxy)、一含有氫氧基(hydroxyl)以及含有羧基(carboxyl)之高分子化合物所組成之群組中之一個。
- 16. 如申請專利範圍第10項所述之固態電解電容器之製造方法,其中該非共軛高分子係選自一含有環氧基(epoxy)、一含有氫氧基(hydroxyl)以及含有羧基(carboxyl)之前驅物所構成之交聯化合物之組成群組中之一個。
- 17. 如申請專利範圍第10項所述之固態電解電容器之製造方法,其中該導電性複合物質係包含一互穿網結構 (intrepenetration network) 導電性複合物質。
- 18. 如申請專利範圍第10項所述之固態電解電容器之製造方法,其中該導電性複合物質係包含一半互穿網結構 (semi-intrepenetration network) 導電性複合物質

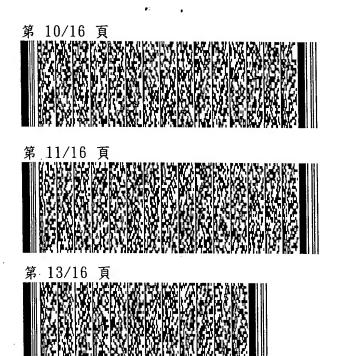




第1圖

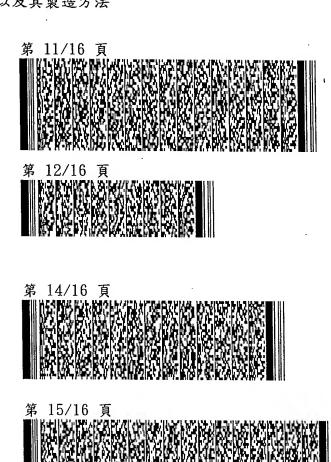


1











雷城何及比較例所製作之雷容器特性、製程良率與可靠度加速試驗之良率結果

<u>ئر</u> بر بر	10		充電老化後特性 			15	1 1	可靠度測試 1000 小時	- दीम
	12	120Hz	100KHz	á H Í	} }	. 12	120Hz	100KHz	ig jų
	*	松北毗南的	等效聯電阻	海電流	良金	靜電容量	等效聯電阻	等效聯電阻	(in A)
	新電浴重 (Juf)	等效學覓回 (mΩ)	_ω (mΩ)	(µA)	(%)	(µF)	(mΩ)	$(m\Omega)$	Ē
	343	98	8	204. 0		344	99	7	2. 96
	348	102	7	124. 2		348	106	7	28. 4
實施例	351	105	8	83. 8	100	354	106	7	8.48
	350	102	7	18.6		350	108	7	3. 12
	349	111	7	51.0		342	111	7	4. 82
	349	119	7	296		1	1	1	1
-	353	103	8	32. 9		346	105	8	3. 32
比較例	353	107	&	57. 3	80	354	106	&	4. 08
	357	103	8	37. 3		6.7	27130	7680	>20000
	350	121	8	230	·	345	122	7	481

衍件 1